技術のお問合せ先: 研究試験事業所 技術営業部 TEL0439-80-2691

Cs-TEM(球面収差補正一透過型電子顕微鏡)による 原子レベル高分解能での極微小組織の材料解析

1. 概要

球面収差補正-透過型電子顕微鏡(Corrector-Spherical Aberration-Transmission Electron Microscopy, Cs-TEM) は、対物レンズおよびコンデンサーレンズの球面収差補正を行うことで、より高分解能なSTEM 像とHAADF像の撮影と、高強度極微細プローブによる原子列からの元素分析が可能な装置です。

従来のSTEMマッピングでは得られなかった原子レベルの高分解能STEM-EDSマッピング(元素存在位置情報)を得 ることが可能です。

2. 高分解能Cs-TEMを用いた高度測定・解析

1	STEMによる 結晶の格子像観察	従来TEMの約10倍向上したSTEM分解能(0.1nm)により、STEM による結晶の格子像を観察可能
2	原子レベルの 高分解能EDS-マッピング	高強度の極微細プローブ(0.1nm)により、B以上の全元素を対象とした 原子レベルの高分解能EDS-マッピングが可能 *元素定性分析/半定量分析/存在位置情報の撮影
3	複数種の析出相、成膜等の 分離同定・解析	電子回折パターンとEDS分析の解析により、複数種の析出相や成膜が存在した場合に於いても、各結晶構造を明らかにし、数nmレベルの析出物を同定することが可能。
4	電子線に弱い材料への適用	低加速電圧(80KV)観察機能により電子線に弱い材料も対応可能。

3. Cs-TEM活用事例

鋼中の粒界偏析および極微細析出物(NbC:長さ10nm 幅0.5nm)のCs-TEM分析事例を示します。 析出物NbC(Cubic)の構造同定はEDS分析および電子回折により決定しています。

◆粒界偏析EDS分析 新型 Cs-TEM 従来 FE-TEM Fe Cr Si 10_{nm} 10nm 8 厚さ att 厚さ 約4nn 不明瞭 20nm 距離 20nm Onm 距離 Onm

◆原子オーダーの観察・EDS分析

Cs-STEM - HAADF像 Cs-STEM - EDSマップ <u>0.5nm</u> ※中央の白色斑点: Nb原子 ※緑色斑点: Nb原子位置

周囲の灰色斑点:Fe原子

Cs-TEMによって極微細析出相の成分情報を可視評価できる

図1:粒界Cr濃化部EDS-ライン分析結果

図2:鋼中極微細NbC析出物のHAADF像(左) およびEDS-マッピング(右)結果

Cs-TEMでは従来TEMでは難しかった数 n mレベルの極薄膜(不働態被膜、粒界偏析、析出物など)の 明瞭なEDS(点、ライン、マッピング等)情報を得ることが可能です。お気軽にご相談ください。



日鉄テクノロジー株式会社

